

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

φ50 μm InGaAs アバランシェ フォトダイオード

1 000 ~ 1 600 nm 帯受光用

NDL5500 は、長距離大容量光通信用に開発された InGaAs アバランシェフォトダイオードです。高速応答、低雑音、低暗電流等のすぐれた特徴をもっています。

応答波長 1 000 ~ 1 600 nm において高感度が得られます。

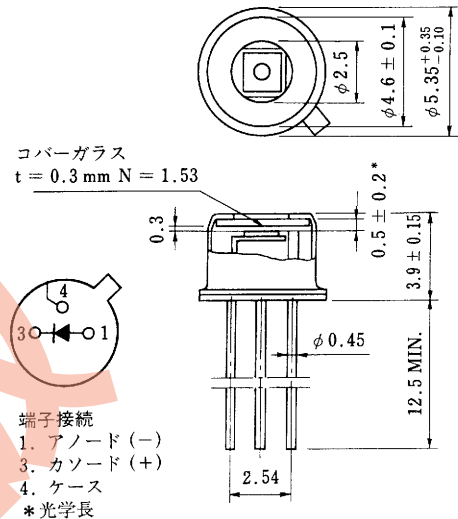
特 徴

- 量子効率が高い。 $\eta = 85\% @ 1300\text{ nm}$
 $\eta = 80\% @ 1550\text{ nm}$
- 暗電流が小さい。 $I_D = 5\text{ nA}$
- 高速応答 $f_c = 1.2\text{ GHz} @ M = 20$
- 光学長が短い。 0.5 mm (ガラス窓表面より)
- 受光部直径 50 μm

絶対最大定格 ($T_C = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
順 電 流	I_F	10	mA
逆 電 流	I_R	500	μA
動 作 温 度	T_C	-40 ~ +70	°C
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +100	°C

外形図 (単位: mm)

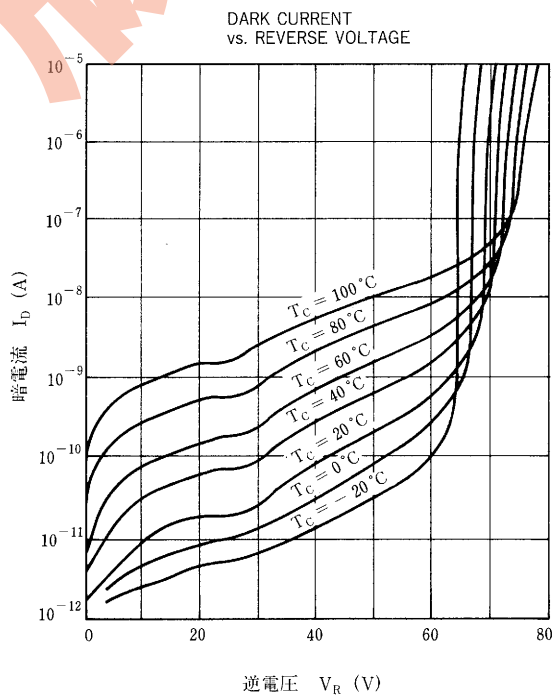
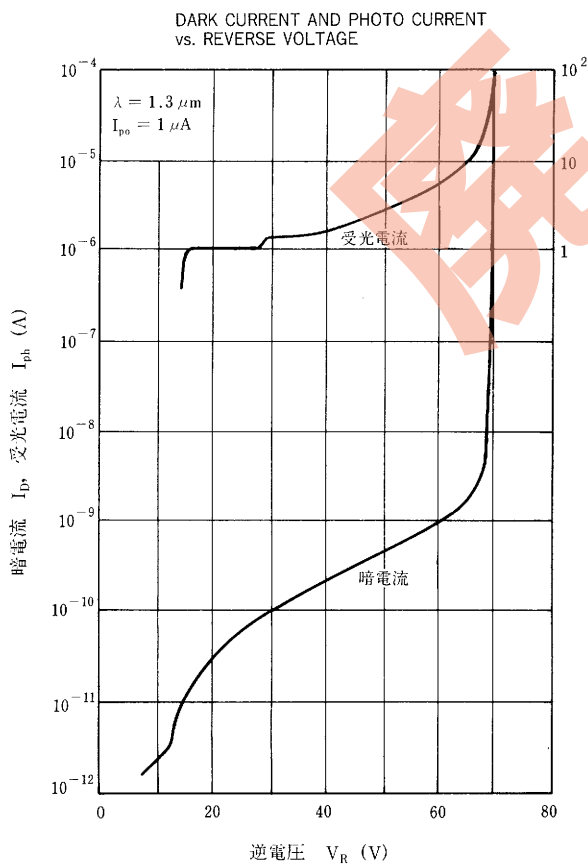
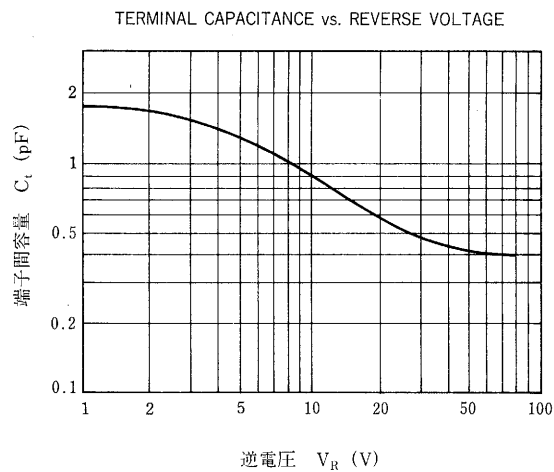
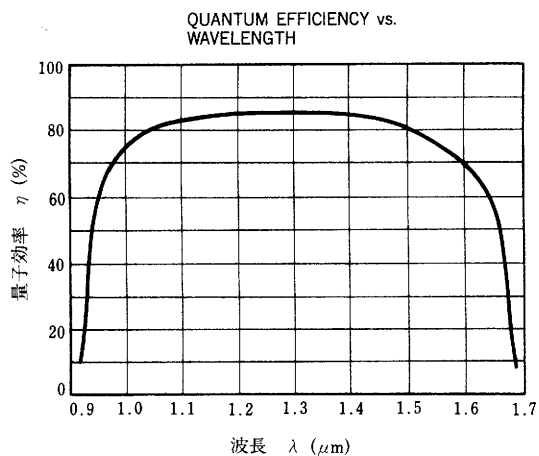


光 - 電気的特性 ($T_C = 25^\circ\text{C}$)

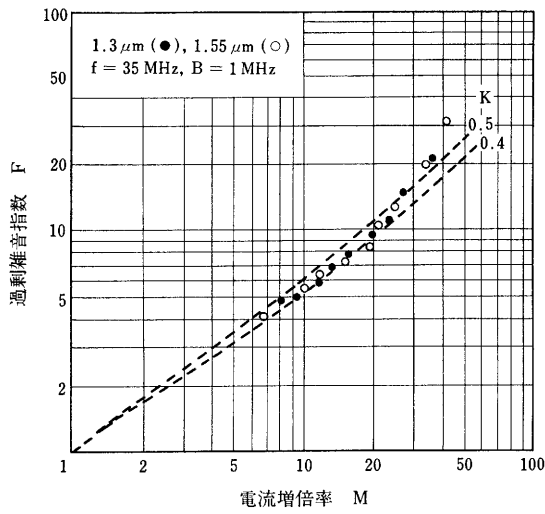
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
逆 降 伏 電 圧	$V_{(BR)R}$	$I_D = 100\ \mu\text{A}$	50	70	100	V
逆 降 伏 電 圧 温 度 係 数	δ^{*1}			0.2		%/°C
暗 電 流	I_D	$V_R = V_{(BR)R} \times 0.9$		5	50	nA
増 倍 暗 電 流	I_{DM}	$M = 2 \sim 10$		1	5	nA
端 子 間 容 量	C_t	$V_R = V_{(BR)R} \times 0.9, f = 1\text{ MHz}$		0.4	0.8	pF
し や 断 周 波 数	f_c	$M = 10$	1			GHz
		$M = 20$		1.2		
量 子 効 率	η	$\lambda = 1300\text{ nm}$	70	85		%
		$\lambda = 1550\text{ nm}$		80		%
受 光 感 度	S	$\lambda = 1300\text{ nm}$	0.73	0.89		A/W
		$\lambda = 1550\text{ nm}$		1.00		
電 流 増 倍 率	M	$\lambda = 1550\text{ nm}, I_{P0} = 1.0\ \mu\text{A}, V_R = V (@ I_D = 1\ \mu\text{A})$	20	40		
過 剩 雑 音 指 数	x	$\lambda = 1300\text{ nm}, 1500\text{ nm}, I_{P0} = 1.0\ \mu\text{A}$		0.7		
過 剩 雑 音 係 数	F	$M = 10, f = 35\text{ MHz}, B = 1\text{ MHz}$		5		
有 効 受 光 径	ϕ_E	$M = 10, 80\% \text{ of Peak}$	30	40		μm

* 1 $\delta = \frac{V_{(BR)R} < 25^\circ\text{C} + \Delta T^\circ\text{C} > - V_{(BR)R} < 25^\circ\text{C} >}{\Delta T \cdot V_{(BR)R} < 25^\circ\text{C} >}$

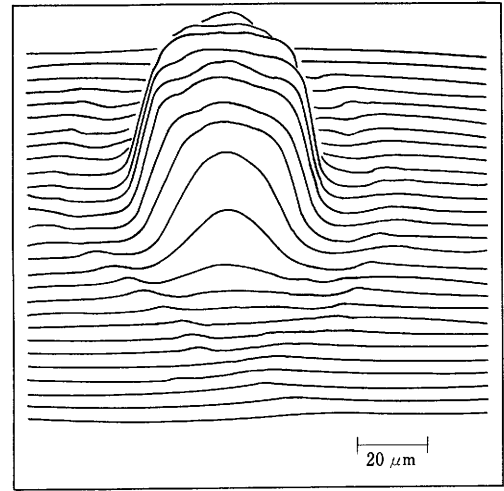
標準特性曲線 ($T_C = 25^\circ\text{C}$)



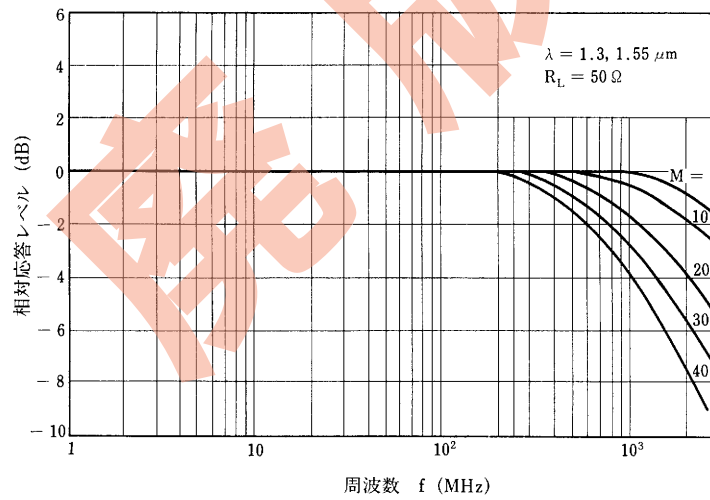
EXCESS NOISE FACTOR vs. MULTIPLICATION FACTOR



MULTIPLICATION MAP



FREQUENCY RESPONSE



InGaAs 受光素子製品系列

特徴 パッケージ	APD			PIN-PD		備考	
	$\phi 50 \mu\text{m}$	$\phi 50 \mu\text{m}$	$\phi 80 \mu\text{m}$	$\phi 80 \mu\text{m}$	$270 \mu\text{m} \times 330 \mu\text{m}$		
TO-18 型 C A N	NDL5520	NDL5500	NDL5510	NDL5405	NDL5406	3ピン	
マイクロレンズ付き TO-18 型 C A N	—	—	—	NDL5405L	—	3ピン	
チップ・オン・キャリア	NDL5520C	NDL5500C	NDL5510C	NDL5405C	NDL5406C		
FCレセプタクル型 モジュール	—	—	—	NDL5405RA1 NDL5405RA2 NDL5405RA3	—	3ピン	
マルチモードファイバ付き 同軸モジュール	NDL5520P NDL5520P1	NDL5501 NDL5501P1	—	NDL5407P NDL5407P1	—	P1:フランジ付き	
シングルモードファイバ付き 同軸モジュール	—	—	—	NDL5408P NDL5408P1	—	光CATV/ アナログ伝送用 P1:フランジ付き	
マルチモードファイバ付き 14ピンDIPモジュール	—	NDL5506P	NDL5516P	—	—	TEC内蔵 NDL5506P:GI-50 NDL5516P:GI-62.5	
マルチモードファイバ付き 6ピンパタフライモジュール	NDL5522P	—	—	NDL5422P*	—	プリアンプ内蔵	
主要特性 ($T_C = 25^\circ\text{C}$)						単位	条件
逆降伏電圧	V_{BR}	70	70	75	—	V	$I_D = 100 \mu\text{A}$
量子効率	η	85	85	85	85	%	$\lambda = 1300 \text{ nm}$
		80	80	80	80		$\lambda = 1550 \text{ nm}$
暗電流	I_D	10	20	60	0.1	0.5	nA $V = V_{\text{op}}$
立ち上がり時間	t_r	$f_C = 2.5 \text{ GHz}$	$f_C = 1 \text{ GHz}$	$f_C = 700 \text{ MHz}$	0.3	4.0	ns 10 - 90 %
立ち下がり時間	t_f	MIN.	MIN.	MIN.	0.3	4.0	ns 90 - 10 %

*NDL5422Pは、 $\phi 50 \mu\text{m}$ で、 $f_C = 2.5 \text{ GHz}$ MIN.です。

[メ モ]

廃版

(メモ)

○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

○本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。

○当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意ください。

○当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海中継機、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

○この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

本製品は外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等（または役務）に該当しますので、日本国外に輸出する場合には、同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。

○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

○この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。

NEC 日本電気株式会社

本社	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (日本電気本社ビル)		
コンシューマ、OA、インダストリ半導体販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (日本電気本社ビル)	東京 (03)3454-1111	
中部支社半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2755	
関西支社半導体販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (日本電気関西ビル)	大阪 (06)945-3178 大阪 (06)945-3200 大阪 (06)945-3208	
北海道支社	札幌市東区南一条二丁目1番1号	(011)231-0161	
東北支社	仙台市青葉区中央一丁目1番1号	(022)261-5511	
関東支社	東京都中央区新富一丁目1番1号	(0196)51-4344	
中部支社	名古屋市東区栄三丁目1番1号	(0236)23-5511	
近畿支社	大阪市東淀川区西中島一丁目1番1号	(0249)23-5511	
中国支社	上海市南京路	(0246)21-5511	
九州支社	福岡市中央区天神一丁目1番1号	(0258)36-2155	
四国支社	高松市東区丸の内一丁目1番1号	(0292)26-1717	
北陸支社	金沢市東区丸の内一丁目1番1号	(045)324-5511	
北海道支社	札幌市東区南一条二丁目1番1号	(0273)26-1255	
東北支社	仙台市青葉区中央一丁目1番1号	(0276)46-4011	
関東支社	東京都中央区新富一丁目1番1号	(0286)21-2281	
中部支社	名古屋市東区栄三丁目1番1号	(0285)24-5011	
近畿支社	大阪市東淀川区西中島一丁目1番1号	(0262)35-1444	
中国支社	上海市南京路	(0263)35-1666	
九州支社	福岡市中央区天神一丁目1番1号	(0266)53-5350	
四国支社	高松市東区丸の内一丁目1番1号	(0552)24-4141	
北陸支社	金沢市東区丸の内一丁目1番1号	(048)641-1411	
立川支社	立川市中央一丁目1番1号	(0425)26-0911	
川崎支社	川崎市川崎区駅前本町一丁目1番1号	(043)227-5441	
津支社	津市東区栄一丁目1番1号	(054)255-2211	
名古屋支社	名古屋市中区栄三丁目1番1号	(0559)63-4455	
大阪支社	大阪市東淀川区西中島一丁目1番1号	(053)452-2711	
京都支社	京都市東山区宇治橋一丁目1番1号	(0762)23-1621	
神戶支社	神戶市東区栄一丁目1番1号	(0776)22-1866	
福岡支社	福岡市中央区天神一丁目1番1号	(0764)31-8461	
北九州支社	北九州市東区小倉一丁目1番1号	(075)352-2261	
山口支社	山口市東区本町一丁目1番1号	(078)332-3311	
広島支社	広島市東区本町一丁目1番1号	(082)242-5504	
岡山支社	岡山市東区本町一丁目1番1号	(0857)27-5311	
鳥取支社	鳥取市東区本町一丁目1番1号	(0862)25-4455	
徳島支社	徳島市東区本町一丁目1番1号	(0878)36-1200	
高松支社	高松市東区本町一丁目1番1号	(0897)32-5001	
松山支社	松山市東区本町一丁目1番1号	(0899)45-4111	
高松支社	高松市東区本町一丁目1番1号	(092)271-7700	
北九州支社	北九州市東区小倉一丁目1番1号	(093)541-2887	

(技術お問い合わせ先)

半導体応用技術本部 超高周波・光デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-8881	半導体応用技術本部 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900
半導体応用技術本部 中部応用システム技術部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2762	
半導体応用技術本部 西日本応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (日本電気関西ビル)	大阪 (06)945-3383	